



一种电子束低温发热测量系统

文献类型: 专利

作者 崔剑; 许皆平; 张正臣; 李明; 徐俊杰; 郁静芳; 樊勇; 季现凯; 江勇

发表日期 2013-12-10

专利国别 中华人民共和国

专利号 CN203720119

专利类型 实用新型

权利人 中国科学院上海应用物理研究所

中文摘要 本实用新型提供一种电子束低温发热测量系统,用于测量电子束在真空、低温环境下的发热量,其特征在于,该系统包括:真空室;位于所述真空室内以供所述电子束穿过的冷屏;位于所述冷屏内并用于接收所述电子束的发热量的金属板;若干设置在所述金属板上的低温传感器;位于所述真空室外并与所述低温传感器连接的温度检测仪;用于保持所述真空室内的真空环境的真空泵;以及用于保持所述真空室内的低温环境的制冷机。本实用新型的测量系统可以精确测量处于真空室内的电子束在低温环境下的发热,为电子束储存环的设计提供参考。

分类号 G01N25/20;G01K17/00;G01K7/22

语种 中文

专利申请号 CN201320811554

源URL [http://ir.sinap.ac.cn/handle/331007/25390]

专题 上海应用物理研究所_中科院上海应用物理研究所2011-2017年

作者单位 中国科学院上海应用物理研究所

推荐引用方式 崔剑,许皆平,张正臣,等. 一种电子束低温发热测量系统. CN203720119. 2013-12-10.
GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: 上海应用物理研究所

浏览	下载	收藏
154	28	0

其他版本

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。